共振点シフト DFB-LD における非対称な回折格子の結合係数の効果 (前方/後方端面光出力比への影響)

Effects of Asymmetric Grating Coupling Coefficients in a Resonance-Shifted DFB-LD 立命館大学大学院 理工学研究科 ^O(M2)中辻 博登, 沼居 貴陽

Grad.School of Sci. & Eng., Ritsumeikan Univ., [°]Hiroto Nakatsuji and Takahiro Numai E-mail: numai@se.ritsumei.ac.jp

1. 研究背景と目的

長距離大容量光ファイバー通信システムの光源とし て用いられる半導体レーザーには、安定した単一軸モ ード動作が要求される.安定した単一軸モード動作を 示す位相シフト DFB-LD[1,2]は日本縦貫光ファイバー 通信システムや日米間光ファイバー通信システム (TPC-4)に搭載されている[3].

レーザー光は、位相シフト DFB-LD の前方/後方両 端面から光出力比約1:1で出射される.これまで、前 方/後方端面の非対称光出力と安定した単一軸モード 動作を両立するために、位相シフトの位置を移動した 位相シフト DFB-LD[4]、均一回折格子とチャープ型回 折格子の界面に位相シフトを導入した DFB-LD[5]、 DFB-LD と DBR を集積した DR-LD[6]が提案されてい る.安定した単一軸モード動作を維持した状態で前方 /後方端面光出力比の向上を目的として、本研究室か ら回折格子のピッチが異なる二つの領域を有する共振 点シフト DFB-LD[7,8]が提案された.

本研究では領域1と領域2の回折格子の深さと前方 /後方端面光出力比との関係を調べた.この結果,従 来よりも前方/後方端面光出力比を向上できる見通し を得たので,報告する.

2. 構造

Fig.1 に解析モデルを示す. 共振点シフト DFB-LD は, 共振器軸方向に沿って二つの領域から構成されている. 領域 1 の領域長を L_1 =732 µm, 回折格子のピッチを A_1 = 0.244 µm とし, 領域 2 の領域長を L_2 =366 µm, 回折 格子のピッチを $A_2 = A_1 + \Delta A$,回折格子の全周期数 N は 4500 とした. 領域 1 の回折格子の深さ D_{g1} を 20 nm~60 nm とし, 領域 2 の回折格子の深さ D_{g2} =30 nm, 40 nm, 50nm に対してシミュレーションした. また, 両端面の反射率は 0%とした. シミュレーションには RSoft 社の LaserMOD を用いた.

3. シミュレーション結果

Fig. 1 に示した光出力 P_1 , P_2 を用いて,前方/後方 端面光出力比 Rを max { P_1/P_2 , P_2/P_1 }と定義した. Fig. 2 に前方/後方端面光出力比 R と領域 1 の回折格子の深 さ D_{g1} との関係を示す.パラメータは,領域 2 の回折 格子の深さ D_{g2} である.回折格子の深さ $D_{g1} = 50$ nm(結 合係数 $\kappa_1 = 107$ cm⁻¹), $D_{g2} = 40$ nm(結合係数 $\kappa_2 = 87$ cm⁻¹),両領域の回折格子のピッチの差 $\Delta A = 0.45$ nm のとき,前方/後方端面光出力比 R は,最大値 84.3 と なった.この値は,従来の最大値 67.6 [8]を上回る.



Fig.2 Front/Rear Facet Light Output Ratio *R*

4. まとめ

共振点シフト DFB-LD において非対称な回折格子の 深さ(結合係数)と前方/後方端面光出力比との関係 についてシミュレーションし,領域1,領域2の回折 格子の深さがそれぞれ $D_{g1} = 50 \text{ nm} (\kappa_1 = 107 \text{ cm}^{-1}),$ $D_{g2} = 40 \text{ nm} (\kappa_2 = 87 \text{ cm}^{-1}), 両領域の回折格子のピッ$ $チの差<math>\Delta A = 0.45 \text{ nm}$ のとき,前方/後方端面光出力比 Rは,従来の最大値67.6 [8]を上回る84.3 となった.

参考文献

- [1] H. A. Haus and C. V. Shank, IEEE J. Quantum Electron, Vol.QE-12, No.9, pp.532-539, 1976
- [2] T. Numai, M. Yamaguchi, I. Mito, and K. Kobayashi, Jpn. J. Appl. Phys., vol.26, No.11, pp.L1910-L1911, 1987.
- [3] T. Numai, "Fundamentals of Semiconductor Lasers" Second Edition (Springer, 2014).
- [4] M. Usami, S. Akiba, and K. Utaka, "Asymmetric λ /4-Shifted InGaAsP/InP DFB Lasers," IEEE J. Quantum Electron., Vol.QE-23, pp.815-821, 1987.
- [5] K. Sato, Y. Muroya, and T. Okuda, IEICE Transl. Electron., Vol.E83-C, pp.855-859,2000.
- [6] M. Aoki, K. Komori, Y. Miyamoto, S. Arai, Y. Suematsu, Electron. Lett. Vol. 25, pp.1650-1651 1989.
- [7] K. Ichikawa and T. Numai, Optik, Vol.127, pp. 6253–6257,2016.
- [8] K. Ichikawa, S. Ito, and T. Numai, Optik, Vol. 127, pp. 12078-12084, 2016.